

	<p><b>SIR862DP-T1-GE3</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">SIR862DP-T1-GE3</a></p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Vishay / Siliconix</a></p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 25V 50A PPAK SO-8</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SIR862DP-T1-GE3.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 847250 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">SIR862DP-T1-GE3</a>
Hersteller	<a href="#">Vishay / Siliconix</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 25V 50A PPAK SO-8
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	847250 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.3V @ 250µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	2.8 mOhm @ 15A, 10V
Verlustleistung (max)	5.2W (Ta), 69W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3800pF @ 10V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	90nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	25V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	50A (Tc)

SIR862DP-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SIR862DP-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SIR862DP-T1-GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ SIR862DP-T1-GE3 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>SIR860-T1-GE3</b> VISHAY SIR860-T1-GE3 VISHAY</p>	 <p><b>SIR864DP-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 30V 40A PPAK 8SO</p>	 <p><b>SIR862DP-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 25V 50A PPAK SO-8</p>	 <p><b>SIR862DP-T1-E3</b> VISHAY SIR862DP-T1-E3 VISHAY</p>
 <p><b>SIR850DP-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 25V 30A PPAK SO-8</p>	 <p><b>SIR864DP</b> SI SIR864DP SI</p>	 <p><b>SIR850DP-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 25V 30A PPAK SO-8</p>	 <p><b>SIR864DP-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 40A PPAK 8SO</p>

### SIR862DP-T1-GE3 Zugehöriges

Mehr

<b>Schlüsselwort</b>	<a href="#">SIR862DP-T1-GE3</a> / Siliconix	<a href="#">SIR862DP-T1-GE3</a> Datenblatt	<a href="#">SIR862DP-T1-GE3</a> Datenblätter	<a href="#">SIR862DP-T1-GE3</a> PDF	<a href="#">Vishay / Siliconix</a> <a href="#">SIR862DP-T1-GE3</a>
<a href="#">SIR862DP-T1-GE3</a> Electronic	<a href="#">SIR862DP-T1-GE3</a> Hersteller	<a href="#">SIR862DP-T1-GE3</a> Komponenten	<a href="#">SIR862DP-T1-GE3</a> Verteiler	<a href="#">SIR862DP-T1-GE3</a> Bild	<a href="#">SIR862DP-T1-GE3</a> Teil
<a href="#">SIR862DP-T1-GE3</a> Preis	<a href="#">SIR862DP-T1-GE3</a> Original	<a href="#">SIR862DP-T1-GE3</a> Bild	<a href="#">SIR862DP-T1-GE3</a> garantiert	<a href="#">SIR862DP-T1-GE3</a> RFQ	<a href="#">SIR862DP-T1-GE3</a> Inventar
<a href="#">SIR862DP-T1-GE3</a> Neu					<a href="#">SIR862DP-T1-GE3</a> Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited